# uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

# Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 2019-2020 *Trabajo de Fin de Grado*

### LINEALIZACIÓN DE OSCILADOR EN ANILLO CONTROLADO POR TENSIÓN MEDIANTE CAPACIDADES CONMUTADAS

Roberto Uceda Gómez

Tutor Eric Gutiérrez Leganés, fecha



Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons **Reconocimiento - No**Comercial - Sin Obra Derivada

#### **RESUMEN**

En este trabajo se desarrolla un estudio cuyo objetivo es el diseño de una nueva arquitectura de convertidor analógico digital por oscilador controlado por tensión que reduzca el ruido y el consumo en comparación con las arquitecturas habituales.

Palabras clave: ADC-VCO, Oscilador en anillo, Conversión Analógico-Digital, CMOS

### **DEDICATORIA**

### ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Objetivos	2
1.2. Marco regulador	2
1.3. Esquema de este documento	2
2. ESTADO DEL ARTE	3
2.1. Tecnología CMOS	4
3. MÉTODOS (?)	6
4. CONCLUSIONES (?)	7
5. ENTORNO SOCIOECONÓMICO (?)	8
6. PRESUPUESTO / PLANIFICACIÓN / PROCESO (?)	9
BIBLIOGRAFÍA	10

### ÍNDICE DE FIGURAS

2.1	Corte de transistor MOSFET	
2.2	Transistor MOS, canal-p	4
2.3	Transistor MOS, canal-n	4
2.4	Inversor CMOS	2

### ÍNDICE DE TABLAS

Lista de abreviaturas		X
-----------------------	--	---

**ADC** Analog to Digital Converter, Convertidor Analógico-Digital

CMOS Complimentary Metal-Oxide Semiconductor

TABLA 1. LISTA DE ABREVIATURAS

#### 1. INTRODUCCIÓN

Los convertidores ADC¹ son onmipresentes en nuestro día a día. Sin ellos, no sería posible realizar una llamada con un teléfono móvil, o disfrutar de un sistema de climatización en nuestro hogar, o utilizar el control de crucero en nuestro coche. El objetivo de estos importantes bloques de la electrónica es convertir señales físicas, como ondas electromagnéticas, temperatura ambiente, o la posición de un eje, en señales digitales interpretables por un sistema basado en la electrónica digital. Una vez tenemos estas señales, normalmente compuestas por un flujo de bits, pueden ser procesadas por un microcontrolador para después tomar las decisiones necesarias para conseguir el objetivo deseado, como activar el compresor del aire acondicionado si la temperatura sube de cierto límite preestablecido.

Cada día que pasa aumenta la demanda de aparatos más rápidos, compactos, y eficientes. Por regla general, la miniaturización de la electrónica tiene un impacto positivo en estos criterios. Los transistores son los componentes fundamentales de los circuitos integrados, donde recae el grueso de consumo y tamaño en un sistema electrónico. Estos transistores aumentan su eficiencia energética según disminuye su tamaño, además de permitir mayores frecuencias de operación. Por esto, existe un gran incentivo en la búsqueda de arquitecturas y técnicas de fabricación que permitan transistores más pequeños.

La ley de Moore ayuda a poner un poco de contexto histórico a esta carrera por la disminución de los transistores. Gordon Moore anunció en 1965 una tendencia en la, por aquel entonces emergente, industria de la electrónica: cada dos años se duplicaba la cantidad de componentes presente en un circuito integrado en la misma superficie [1]. A más componentes, mayor poder de procesamiento, pero también mayor coste de fabricación por la complejidad y delicadeza requerida en los procesos.

#### Motivación del trabajo

Debido a las altas velocidades de reloj y los requisitos de consumo y fabricación (espacio ocupado, número de componentes), los ADC usados actualmente presentan problemas. Los ADC basados en la arquitectura sigma delta necesitan un amplificador operacio-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Analog to Digital Converter. En español, Convertidor Analógico a Digital

nal a modo de integrador. Los ADC basados en osciladores, bien necesitan un integrador de manera similar a los sigma-delta, o bien necesitan una compensación de linearidad mediante un circuito digital. Los amplificadores operacionales y los circuitos de compensación requieren de mucho espacio y gran número de componentes, además de consumir más de lo deseable. Este trabajo se centra en la búsqueda de una nueva arquitectura que permita ahorrar la necesidad de circuitos de compensación o amplificadores operacionales, manteniendo o mejorando el comportamiento lineal, la resolución, y el ancho de banda de las arquitecturas ya existentes.

#### 1.1. Objetivos

por decidir

#### 1.2. Marco regulador

preguntar a Eric

#### 1.3. Esquema de este documento

por decidir

#### 2. ESTADO DEL ARTE

Para entender las arquitecturas de ADC modernas es imprescindible conocer primero los bloques fundamentales sobre los que se asienta la microelectrónica actualmente: los transistores MOSFET<sup>2</sup>.

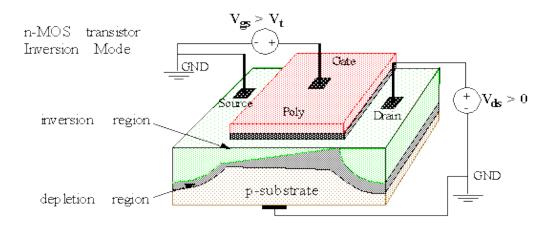


Fig. 2.1. Corte de transistor MOSFET<sup>3</sup>

Un transistor MOSFET es un tipo de transistor bipolar que se usa para amplificar y conmutar señales eléctricas dentro de un circuito. Se compone de cuatro entradas: fuente, puerta, drenador, y sustrato, que normalmente está conectado a la fuente. Cuando se aplica un voltaje en la puerta, se crea un canal en el medio semiconductor que permite el paso de corriente entre la fuente y el drenador. Podemos distinguir dos tipos de transistores MOS: los canal-n y los canal-p, dependiendo del dopaje del silicio usado en su fabricación. Los canal-n tienen un dopaje negativo en el silicio de la fuente y el drenador, que se consigue añadiendo impurezas de un elemento como fósforo, dejando electrones libres que actúan como portadores de carga. En el caso de los canal-p, se dopan con elementos como boro, que dejan huecos (ausencia de electrones en capas de valencia), y estos actúan como portadores de carga.

Estos son los símbolos más usados para representar transistores MOS:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Fuente: http://ece-research.unm.edu/jimp/vlsi/slides/chap2\_1.html

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Fuente: Analog Integrated Circuit Design[2]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Fuente: Analog Integrated Circuit Design[2]

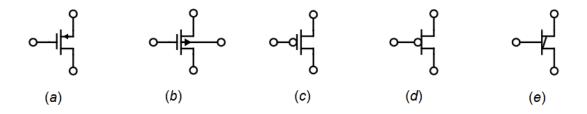


Fig. 2.2. Transistor MOS, canal-p<sup>4</sup>

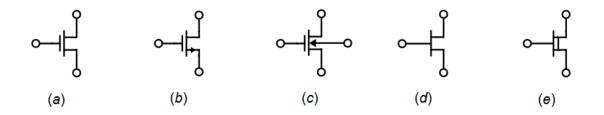


Fig. 2.3. Transistor MOS, canal-n<sup>5</sup>

#### 2.1. Tecnología CMOS

La tecnología de fabricación CMOS<sup>6</sup> utiliza una combinación de transistores MOS de canal n y canal p para implementar las funciones de un microprocesador. Por ejemplo, un inversor (puerta lógica NOT) se consigue con la siguiente disposición:

Truth Table	Integrated Circuit
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$V_{in}$ $T_2$ $T_1$ $T_1$

Fig. 2.4. Inversor CMOS<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Fuente: https://www.oreilly.com/library/view/introduction-to-digital/9780470900550/chap5-sec008.html

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Complementary MOS

Los circuitos CMOS tienen un bajo consumo, tienen una buena resistencia al ruido, y son relativamente fáciles de diseñar. Es por esto que se ha convertido en la tecnología dominante en los microcircuitos.

#### 2.2. Convertidores analógico-digital

# **3. MÉTODOS** (?)

### 4. CONCLUSIONES (?)

# 5. ENTORNO SOCIOECONÓMICO (?)

## 6. PRESUPUESTO / PLANIFICACIÓN / PROCESO (?)

### BIBLIOGRAFÍA

- [1] G. E. Moore, "Cramming more components onto integrated circuits," *Electronics*, vol. 38, n.º 8, 1965.
- [2] K. W. M. Tony Chan Carusone David A. Johns, *Analog Integrated Circuit Design*, 2.a ed. Wiley, 2012.